PTO/SB/21 (08-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Application Number 10/604,862 **TRANSMITTAL Filing Date** 08/22/2003 **FORM** Ming-Yang Chao **First Named Inventor** (to be used for all correspondence after initial filing) Group Art Unit **Examiner Name**

Total Number	of Pages in This Subn	Attorney Docket Number MTKP0032USA				
		ENCLOSURES (check all that apply)				
Extension of Time R Express Abandonn Information Disclos Certified Copy of Pocument(s) Response to Missir Incomplete Application	eclaration(s) Request ment Request sure Statement riority	Assignment Papers (for an Application) Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) After Allowance Communication to Group (Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below): Remarks				
	SIGNATU	JRE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT				
Firm or Winston Hsu, Reg. No.: 41,526						
Signature	h	Instantan				
Date .	8/	121/2003				
CERTIFICATE OF MAILING						
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Poetal Service with sufficient poetage as first also						

CE	RTIFICATE OF MAILING					
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:						
Typed or printed name						
Signature	Date					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 0 3 MMB SEE

PTO/SB/17 (01-03)

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE tion Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$)	0.00

Complete if Known				
Application Number	10/604,862			
Filing Date	8/22/2003			
First Named Inventor	Ming-Yang Chao			
Examiner Name				
Art Unit				
Attomacy Dealest No.	MTKD0032USA			

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FEE CALCULATION (continued)				
Check Credit card Money Other None			3. ADDITIONAL FEES					
Deposit Account:				arge Entity Small Entity				
Deposit		7 I	Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	50-0801	<u> </u>	1051	130	2051		Surcharge - late filing fee or oath	Fee Faid
Deposit Account Name	North America International Patent Office		1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
	ioner is authorized to: (check all that apply)	- I	1053	130	1053	130	Non-English specification	
II I	(s) indicated below Credit any overpayment	ents	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any	additional fee(s) during the pendency of this appli	ication	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	l 1
	(s) indicated below, except for the filing fee lentified deposit account.		1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
	FEE CALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC F			1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
i e	Small Entity	- 1	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
	Fee Fee Fee Description Fee P	aid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750	2001 375 Utility filing fee	l	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330	2002 165 Design filing fee		1401	320	2401	160	Notice of Appeal	LI
1003 520	2003 260 Plant filing fee	-11	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750	2004 375 Reissue filing fee	71	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160	2005 80 Provisional filing fee	_ 11	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
ļ ,	SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	71	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
2 EVIDA		ᆵ	1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
Z. EXTRA	CLAIM FEES FOR UTILITY AND REIS	- 1	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims		Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee	
Independent	-20** = X -3** = X -3** = X	∹∥	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Claims Multiple Deper		==1	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
	L	1	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Fee Fee	Fee Fee Fee Description	ŧ	1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)	1	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18	2202 9 Claims in excess of 20	. [1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection	
1201 84	2201 42 Independent claims in excess of						(37 CFR 1.129(a))	
1203 280	2203 140 Multiple dependent claim, if not	paid	1810	750	2810	375	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 84	2204 42 ** Reissue independent claims over original patent]	1801	750	2801	375	Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18	2205 9 ** Reissue claims in excess of 2 and over original patent	0	1802	900	1802	900		
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00			Other fee (specify)					
**or number	r previously paid, if greater; For Reissues, see abo	<u></u>	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00					
	, 000 000						. (-) ((+) 0.00	

SUBMITTED BY							(Complete	(if applicable)	7
Name (Print/Type)	Winston Hsu	1	_ 1 .		Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350	
Signature		1	In	elo	n A-	n	Date	8/29/20	2013
	MADNING								

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO:

SEP 0 3 7003 EE

PTO/SB/02B (11-00)

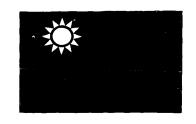
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE on Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:				
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	Attached?
092100147	Taiwan, R.O.C.	01/03/2003		7	

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



es es es es



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 01 月 03 日

Application Date

申 請 案 號: 092100147

Application No.

申 請 人: 聯發科技股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General



發文日期: 西元 2003 年 2 月 19 日

Issue Date

發文字號: 09220156350

Serial No.





申請日期:		IPC分類							
申請案號:									
(以上各欄)	由本局填言	發明專利說明書							
	中文	高速光學記錄器							
發明名稱	英_ 文	HIGH SPEED OPTICAL RECORDING APPARATUS							
	姓 名 (中文)	1. 趙銘陽							
	(英文)	1. Chao, Ming-Yang							
<i>後</i> 明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	住居所 (中 文)	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段九七0號七樓							
	住居所 (英 文)	1.7F, No. 970, Sec. 4, Chung-Hsing Rd., Chu-Tung Town, Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.							
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 聯發科技股份有限公司							
	名稱或 姓 名 (英文)	1. MediaTek Inc.							
三、	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW							
7請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區創新一路13號1F (本地址與前向貴局申請者相同)							
	住居所 (營業所) (英 文)								
	代表人(中文)	1. 蔡明介							
	代表人(英文)	1.Tsai, Ming-Kai							
MIII (CACILITA	gu isatykannanik	NO DESCRIPTION OF THE PROPERTY							



四、中文發明摘要 (發明名稱:高速光學記錄器)

本發明提供一種高速光學記錄器,其依據輸入之一 RLL調變波形來產生一寫入訊號以控制一光學讀寫頭的寫 入功率,該高速光學記錄器包含有一粗略延遲器,會依 據一組寫入策略參數來產生一粗略延遲參數及精密延遲 參數,並依據粗略延遲參數延遲該八對十四調變波形以 產生一第一延遲訊號;以及一精密延遲鏈,其包含有複 數個相互串接之延遲單元,各該延遲單元會將該第一延 遲訊號延遲一預定時間,該精密延遲鏈會依據該精密延 遲參數來延遲該第一延遲訊號以產生該寫入訊號。

、(一)、本案代表圖為:第 1 圖 (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

10 高速光學記錄器

12 時脈產生器

14 調整資料儲存單元 16

16 粗略延遲器

18 精密延遲鏈

20 延遲調整狀態機

六、英文發明摘要 (發明名稱:HIGH SPEED OPTICAL RECORDING APPARATUS)

A high speed optical recording apparatus for generating a write signal according to an inputted RLL modulated waveform to control a write power of a pickup. The high speed optical recording apparatus contains a rough delay element, which generates rough delay parameters and fine delay parameters according to a set of write strategy parameters, and delay the EFM





四、中文發明摘要 (發明名稱:高速光學記錄器)

 22
 略延遲計數器
 24
 EFM輸入介面

 26
 資料儲存設定介面
 28
 EFM編碼器

 30
 微處理器
 32
 光學讀寫頭

 34
 鎖相迴路
 36
 頻率除法器

六、英文發明摘要 (發明名稱: HIGH SPEED OPTICAL RECORDING APPARATUS)

waveform to generate a first delay signal. The high speed optical recording apparatus also ontains a fine delay chain, which includes a plurality of delay cells in serial connection. Each delay cell delays the first delay signal with a predetermined time period. The fine delay chain delays the first delay signal according to the fine delay parameter to generate the write



四、中文發明摘要	(發明名稱:高速光學記錄器)
六、英文發明摘要	(發明名稱: HIGH SPEED OPTICAL RECORDING APPARATUS)
signal.	
orginar.	

一、本案已向	•		
國家(地區)申請專利	申請日期	案 號	主張專利法第二十四條第一項優先
·			
•			
		無	
		7111	
二、□主張專利法第二十二	丘條之一第一項優	先權:	
申請案號:			
日期:		無	
三、主張本案係符合專利法	去第二十條第一項	□第一款但書或	□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存力	冷國外:		
寄存國家:		L	
寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於	於國內(本局所指定	ミ之寄存機構):	
寄存機構:		<u></u>	
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易力	冷獲得,不須寄存。	•	
		•	

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

本發明提供一種高速光學記錄器(High Speed Optical Recording Apparatus),尤指一種同時包含有一計數器及一延遲鏈(Delay Chain)的高速光學記錄器。

先前技術

一 光 學 儲 存 裝 置 (如 CD燒 錄 機 或 DVD燒 錄 機 等) 於 儲





五、發明說明 (2)

存資料至一光學儲存媒體(如CD光碟或DVD光碟等)時, 會將該資料利用該光學儲存裝置之一編碼器(Encoder) 轉換為該光學儲存媒體之儲存格式,於目前習知技術 中,此種光學儲存媒體之儲存格式通常係為一RLL調變波 形(Run Length Limited code, 在 CD-ROM格 式 內 使 用 Eight-to-Fourteen Modulation, 以下皆以 CD格 式之 EFM Waveform說明),該EFM波形係將欲儲存於該光學儲存媒 體上之資料以不同時間長度之方波來代表,通常該方波 之每一脈衝及脈衝間的距離均為三倍EFM基準週期(EFM Base Frequency) 至十一倍 EFM基準週期之間之長度,而 該 EFM波形則用來作為該光學儲存裝置將資料燒錄至該光 字儲存媒體之依據。當資料儲存於該光學儲存媒體上 時,係利用該光學儲存媒體上長度不一之複數個平坦區 (Land)及凹洞區(Pit)來代表該資料之內容,而該平 坦區及凹洞區之長度則剛好對應於該EFM波形之波形長 度,利用此一對應關係,則該光學儲存裝置可以將資料 儲存至該光學儲存媒體上。

當該光學儲存裝置利用其 EFM編碼器產生該 EFM波形後,會將該 EFM波形輸入一光學記錄器 (Optical Recording Device)中,並利用該光學記錄器對該 EFM波進行延遲 (Delay),以產生複數個寫入訊號,用以控制該光學儲存裝置上之一光學讀寫頭 (Pickup)的寫入功率。而該光學讀寫頭則會依據該寫入訊號發射出雷射





五、發明說明 (3)

光,依序於該光學儲存媒體之表面上蝕刻出複數個長度不一之凹洞區,進而形成前述之連續的平坦區及凹洞區交錯出現的軌跡。於習知技術中,該光學記錄器通常係利用至少一計數器(Counter)配合一比較器(Comparator)來延遲該 EFM波形以產生該寫入訊號(請參閱美國專利序號: US 5,526,333),亦即該計數器會依據輸入之一時脈訊號持續計數,而該比較器則會比較與該 EFM波形相關之一控制訊號之值以及該計數器之計數結果以延遲該 EFM波形並輸出該寫入訊號,再利用該寫入訊號來控制該光學讀寫頭的寫入功率。由上述之動作原理可知,該光學記錄器延遲該 EFM波形以產生該寫入訊號又解析度(Resolution)即等於該時脈訊號之週期。

然而隨著光學儲存媒體之燒錄技術的進步,能夠以更快的速度將資料燒錄至一光學儲存媒體的光學儲存與的光學儲存與關於學問,在實際與關於了,在學問,與不產生驅動該計數器之時脈亂。 對對器以及用來產生驅動該計數器之時脈亂。 對對點以及用來產生驅動該計數器之時,的一 實極限,習知技術之光學記錄器將面臨於非常高速之燒 錄速度下,其用來延遲該 EFM波形以產生該寫入訊號之 錄速度下,其用來延遲該 EFM波形以產生該寫入訊號之時 脈訊號的解析度不足的問題,而導致該光學儲存裝置 脈訊號的解析度寫頭於該光學儲存媒體上蝕刻出位 對精確的凹洞區,此一現象將造成於資料讀取時之 夠精確的凹洞區,此一現象將造成於資料讀取時之 到精確的現象。





五、發明說明 (4)

發明內容

因此本發明之主要目的在於提供一種同時包含有一計數器及一延遲鏈的高速光學記錄器,以解決上述習知光學記錄器延遲解析度不足的問題。

根據本發明之申請專利範圍,係揭露一種高速光學 記錄器,其係設置於一光學儲存裝置中,該高速光學記 錄 器 係 依 據 輸 入 之 一 RLL變 波 形 來 產 生 一 寫 入 訊 號 以 控 制 兹 光 學 儲 存 裝 置 之 一 光 學 讀 寫 頭 的 寫 入 功 率 , 該 高 速 光 學記錄器包含有一時脈產生器,用來產生一第一時脈訊 號;一調整資料儲存單元,其內儲存有複數組寫入策略 參 數 , 並 會 依 據 該 RLL調 變 波 形 從 該 寫 入 策 略 参 數 中 選 擇 並輸出一組相對應之寫入策略參數;一粗略延遲器 氣 連 接 於 該 時 脈 產 生 器 以 輸 入 該 第 一 時 脈 訊 號 , 並 電 氣 連接於該調整資料儲存單元以輸入該組相對應之寫入策 略多數,該粗略延遲器會依據該組相對應之寫入策略參 數 來 產 生 一 精 密 延 遲 參 數 , 同 時 依 據 該 第 一 時 脈 訊 號 及 該組相對應之寫入策略參數來延遲該八對十四調變波形 以產生一第一延遲訊號;以及一精密延遲鏈,其係電氣 一接於該粗略延遲器以輸入該第一延遲訊號及該精密延 遲多數,該精密延遲鏈包含有複數個相互串接之延遲單 元 , 各 該 延 遲 單 元 係 用 來 將 該 第 一 延 遲 訊 號 延 遲 一 預 定





五、發明說明 (5)

時間,該精密延遲鏈會依據該精密延遲參數來延遲該第一延遲訊號以產生該寫入訊號。

本發明之高速光學記錄器係利用一精密延遲鏈中之複數個延遲單元來提供該高速光學記錄器所需要之精密延遲,由於各該延遲單元會將輸入之訊號延遲一預定時間,而該預定時間係為一長度非常短的時間週期,因此只要對各該延遲單元作適當的調整,本發明之高速光學記錄器即可以得到足夠精細之延遲解析度,以解決習知技術的問題。

實施方式

請參閱圖一,圖一中顯示本發明之高速光學記錄器(High Speed Optical Recording Apparatus)10的功能方塊圖,高速光學記錄器10包含有一時脈產生器12,用來產生一第一時脈訊號CLK1;一調整資料儲存單元14,其內儲存有複數組寫入策略參數(Write Strategy Parameter);一粗略延遲器16,電連接於時脈產生器12以輸入第一時脈訊號CLK1,並電連接於調整資料儲存單元14;以及一精密延遲鏈18,其係電連接於粗略延遲器16,精密延遲鏈18包含有複數個相互串接之延遲單元,各該延遲單元係用來將訊號延遲一預定時間。





五、發明說明 (6)

於本發明之較佳實施例中,時脈產生器 12另外會產 生一第二時脈訊號 CLK2, 而粗略延遲器 16則包含有一延 遲調整狀態機 (Delay Adjustment State Machine) 20, 電連接於時脈產生器 12以輸入第二時脈訊號 CLK, 並電連接於調整資料儲存單元14;以及一粗略延遲計數 器 (Rough Delay Counter) 22, 電連接於時脈產生器 12 以輸入第一時脈訊號CLKI,並電連接於延遲調整狀態機 20。高速光學記錄器10另包含有一八對十四調變輸入介 面(EFM Input Interface,以下稱為EFM輸入介面) 24, 其係自一 EFM編碼器 28輸入一八對十四調變波形 (即 FFM波形)並產生一位址訊號;以及一資料儲存設定介面 (Data Storage Setting Interface) 26, 電連接於調 整資料儲存單元14,並電連接於一微處理器30以輸入並 储存該複數組寫入策略參數至調整資料儲存單元 14。而 精密延遲鏈 18則會電連接至一光學讀寫頭32。請注意, 在不影響本發明之實施的情形下,粗略延遲計數器22亦 可用一粗略延遲移位暫存器 (Rough Delay Shift Register)來代替。

時脈產生器 12通常係利用一鎖相迴路 34來產生第一時脈訊號 CLK並將之輸入粗略延遲計數器 22, 而第一時 灬訊號 CLK之週期係為該 EFM波形之基準週期 (EFM Base Period) 的整數倍分之一。時脈產生器 12中亦包含有一頻率除法器 36, 其係用來輸入第一時脈訊號 CLK以將之





五、發明說明 (7)

降頻而產生第二時脈訊號 CLK₂,第二時脈訊號 CLK則會被輸入延遲調整狀態機 20,且其週期係剛好等於該 EFM波形之基準週期。而精密延遲鏈 18中之各該延遲單元,則會被設計成剛好使得該預定時間之長度為一較第二時脈訊號 CLK之週期為小、且為該 EFM基準週期之整數倍分之一的值,例如該預定時間為該 EFM基準週期的 1/32。

調整資料儲存單元 14中所儲存之該複數組寫入策略 參數條代表用來驅動光學讀寫頭32之一寫入功率波形的 波形特徵,而針對一光學儲存媒體上之每一個凹洞區 **炒該 EFM波 形 上 均 有 相 對 應 之 一 前 一 平 坦 區 (Previous** Land)、一目前凹洞區 (Current Pit)、以及一後一平 坦 區 (Next Land)。於 每 一 組 寫 入 策 略 參 數 中 , 有 部 份 之寫入策略參數是依據該前一平坦區及該目前凹洞區之 長度來決定,部份是依據該目前凹洞區及該後一平坦區 之長度來決定,而部份則僅依據該目前凹洞區之長度來 决定。因此,於調整資料儲存單元 14中,該複數組寫入 策略參數即是依此原則而分成前一平坦區—目前凹洞區 (LP) 參數及目前凹洞區 — 後一平坦區 (PL) 兩部份 (僅 依 據 該 目 前 凹 洞 區 之 長 度 決 定 的 寫 入 策 略 參 數 可 以 被存入以上雨部份中之任一部份)。又由於每一平坦區 .. 凹洞區之長度均介於三倍 EFM基準週期及十一倍 EFM基 準 週 期 之 間 (於 圖 一 中 EFM基 準 週 期 係 表 示 為 T) , 故 不 同之平坦區及凹洞區之長度的組合可對應至調整資料儲





五、發明說明 (8)

存單元 14中不同的寫入策略參數,如圖一所示。而由 EFM 輸入介面所產生之該位址訊號,即是依據該前一平坦區、該目前凹洞區、及該後一平坦區之長度而決定,並對應到適合的寫入策略參數。

請注意,調整資料儲存單元 14為了能夠與高速之寫 入動作相互配合,其通常為一存取速度快速的揮發性記憶體(Volatile Memory),以確保調整資料儲存單元 14之動作速度不會拖累高速光學記錄器 10整體的效率,然而揮發性記憶體中所儲存的資料會因為其電源關閉而消失,因此調整資料儲存單元 14會於每一次電源啟動時經田資料儲存設定介面 26從微處理器 30中之一非揮發性記憶體將該複數組寫入策略參數下載至其中。

接下來將詳述本發明之高速光學記錄器 10的動作原理。當 EF M輸入介面 24從 EF M編碼器 28之處輸入一 EF M波形後, EF M輸入介面會依據該前一平坦區、該目前凹洞區,以及該後一平坦區之長度產生一位址訊號,並將該 EF M波形輸出至延遲調整狀態機 20中,且將該位址訊號輸出至調整資料儲存單元 14中。當調整資料儲存單元 14接收到該位址訊號後,其會依據該位址訊號中之資訊分別從該P參數及該 PL參數中選取一組相對應之寫入策略參數,並將該組相對應之寫入策略參數輸出至延遲調整狀態機 20中。



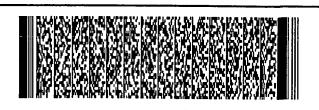


五、發明說明 (9)

接下來延遲調整狀態機 20會依據該組相對應之寫入策略參數來產生一粗略延遲參數以及一精密延遲參數,同時依據第二時脈訊號 CLK及該組相對應之寫入策略參數來延遲該 EFM波形以產生一第二延遲訊號並將第二延遲訊號 S及該粗略延遲參數輸出至粗略延遲計數器 22中,且將該精密延遲參數輸出至粗略延遲計數器 22中,且將該精密延遲參數輸出至精密延遲鏈 18中。而粗略延遲針數器 22會依據第一時脈訊號 CLK及該粗略延遲參數來延遲第二延遲訊號 S以產生一第一延遲訊號 S,並將塞延遲鏈 18中。最後精密延遲參數來延遲第一延遲離 18中。最後精密延遲達 18中。最後精密延遲達 18中。最後精密延遲達 18中。最後精密延遲第一延遲前 32中。請注意,由於前述之該寫入功率波形通常係由複數中。請注意,由於前述之該寫入功率波形通常係由複數可經形特徵不同之寫入訊號 S所合成,故寫入訊號 S即可經由此一機制來控制光學讀寫頭 32之寫入功率以對一光學儲存媒體進行檢刻。

請參閱圖二,圖二中顯示圖一中之粗略延遲計數器 22的功能方塊圖。於本發明之較佳實施例中,粗略延遲計數器 22包含有一輸入暫存器 42,其係為一 D型正反器 (D-Flipflop),其輸入端電連接於延遲調整狀態機 20輸入第二延遲訊號 S而其時脈端則輸入第二時脈訊號 CLK 2,其輸出訊號則被輸入至一比較器 46,粗略延遲計數器 22亦包含有一四位元計數器 44,其時脈端亦輸入第



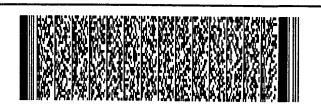


五、發明說明 (10)

二時脈訊號 CLK 2, 而其四輸出端均電連接至比較器 46, 同時該粗略延遲訊號亦輸入至比較器 46, 該粗略延遲訊號係代表粗略延遲計數器 22以第二時脈訊號 CLK為單位,延遲第二延遲訊號 S之量,在此為一四位元之數字。最後比較器 46會比較該粗略延遲訊號與該計數器 44之輸出訊號,當前述二者之值相等時才將第二延遲訊號 S經由一輸出暫存器 48(其亦為一 D型正反器)輸出,而該輸出訊號即為第一延遲訊號 S₁。請注意,在不影響本發明之實施的情況下,計數器 44亦可以用一位移暫存器(Shift Register)來取代。

請參閱圖三中顯示圖一中之精密延遲鏈 18的功能 6 數值 6 中央較佳實 7 中央較佳實 6 中央 6 數值 7 中央 6 数值 8 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 2 和 5 3 和 5 2 和 5 3 和 5 3 和 6 的 8 3 的





五、發明說明 (11)

如前所述,由於延遲調整狀態機20是依據第二時脈 訊號 CLK來延遲該 EFM波形,因此延遲調整狀態機 20延遲 該EFM波形之解析度即為第二時脈訊號CLK之週期,也就 是該 EFM基準週期之長度。同樣地,粗略延遲計數器 22是 以第一時脈訊號CLK為單位來延遲該第二延遲訊號S2,因 此粗略延遲計數器 22延遲該之第二延遲訊號 S解析度即 為第一時脈訊號 CLK 之週期。而精密延遲鏈 18則是以該 預定時間為單位來延遲該第一延遲訊號了,因此精密延 遲鏈 18延遲該第一延遲訊號 S之解析度即為第一時脈訊 號CLK之週期。請注意,於本實施例中之第一時脈訊號 CLK之週期、該預定時間以及該延遲單元之輸出端的選 収,可依照設計之需要而有相對應之調整,舉例來說, 若第一時脈訊號 CLK 之週期為該 EFM基準週期的 1/4, 而 該 預 定 時 間 為 該 EFM基 準 週 期 的 1/32, 則 多 工 器 54需 要 從 第一延遲訊號S及其他七個經不同數量的延遲單元延遲 後的訊號中選取其一來作為該寫入訊號,同時該粗略延 遲訊號及該精密延遲訊號之值亦需要作相對應之設定。

相較於習知技術中僅使用計數器來進行延遲的光學記錄器,本發明之高速光學記錄器係同時使用計數器及延遲鏈來完成訊號延遲之功能,不但能夠解決習知技術高度燒錄時臨面之解析度不足的問題,並且具有可以同時支援低速燒錄以及高速燒錄的功能,具有高度之向下相容性。





五、發明說明 (12)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變與修飾,皆屬於本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖示之簡單說明

- 圖一為本發明之高速光學記錄器的功能方塊圖。
- 圖二為圖一中之粗略延遲計數器的功能方塊圖。
- 圖三為圖一中之精密延遲鏈的功能方塊圖。

圖示之符號說明

- 10高速光學記錄器12時脈產生器14調整資料儲存單元16粗略延遲器18精密延遲鏈20延遲調整狀態機
- 22 粗略延遲計數器
 24 EFM輸入介面

 26 資料儲存設定介面
 28 EFM編碼器
- 30 微處理器 32 光學讀寫頭
- 34 鎖相迴路
 36 頻率除法器

 42 輸入暫存器
 44 計數器
- 46比較器48輸出暫存器52反向器54多工器



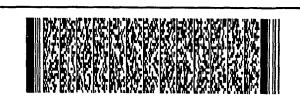
- 1. 一種高速光學記錄器(High Speed Optical Recording Apparatus),其係設置於一光學儲存裝置中,該高速光學記錄器係依據輸入之一 RLL調變(Run Length Limited code)波形來產生一寫入訊號以控制該光學儲存裝置之一光學讀寫頭(Pickup Head)的寫入功率,該高速光學記錄器包含有:
 - 一時脈產生器,用來產生一第一時脈訊號;
- 一調整資料儲存單元(Adjustment Data Storage Unit),其內儲存有複數組寫入策略參數(Write Strategy Parameter),並會依據該八對十四調變波形從該寫入策略參數中選擇並輸出一組相對應之寫入策略參數;
- 一粗略延遲器,電連接於該時脈產生器以輸入該第一時脈號,並電連接於該調整資料儲存單元以輸入該組相對應之寫入策略參數,該粗略延遲器會依據該組相對應之寫入策略參數來產生一精密延遲參數,同時依據該第一時脈訊號及該組相對應之寫入策略參數來延遲該八對十四調變波形以產生一第一延遲訊號;以及
- 一精密延遲鏈(Fine Delay Chain),其係電連接於該粗略延遲器以輸入該第一延遲訊號及該精密延遲參數,該精密延遲鏈包含有複數個相互串接之延遲單元, 上該延遲單元係用來將該第一延遲訊號延遲一預定時間,該精密延遲鏈會依據該精密延遲參數來延遲該第一 延遲訊號以產生該寫入訊號。





- 2. 如申請專利範圍第 1項所述之高速光學記錄器,其中該時脈產生器另產生一第二時脈訊號,且該粗略延遲器 另包含有:
- 一延遲調整狀態機(Delay Adjustment State Machine),電連接於該時脈產生器以輸入該第二時脈訊號,並電連接於該調整資料儲存單元以輸入該組相對應之寫入策略參數,該延遲調整狀態機會依據該組相對應之寫入策略參數來產生一粗略延遲參數以及該精密延遲參數,同時依據該第二時脈訊號及該組相對應之寫入策略參數來延遲該八對十四調變波形以產生一第二延遲訊號;以及
- 一粗略延遲計數器(Rough Delay Counter)或粗略延遲移位暫存器(Rough Delay Shift Register),電連接於該時脈產生器以輸入該第一時脈訊號,並電連接於該調整狀態機以輸入該粗略延遲參數及該第二延遲訊號,該粗略延遲計數器會依據該第一時脈訊號及該粗略延遲參數來延遲該第二延遲訊號以產生該第一延遲訊號。
- 3. 如申請專利範圍第 1項所述之高速光學記錄器,其另一含有一八對十四調變輸入介面 (EFM Input Interface) ,其係輸入該八對十四調變波形並產生一位址訊號。





- 4. 如申請專利範圍第 3項所述之高速光學記錄器,其中該八對十四調變輸入介面係依據該八對十四調變波形中之一前一平坦區(Land)、一目前凹洞區(Pit)、以及一後一平坦區之資訊來產生該位址訊號。
- 5. 如申請專利範圍第 3項所述之高速光學記錄器,其中該粗略延遲器係電連接於該八對十四調變輸入介面以輸入該八對十四調變波形。
- 7. 如申請專利範圍第 1項所述之高速光學記錄器,其另包含有一資料儲存設定介面 (Data Storage Setting Interface),電連接於該調整資料儲存單元,並電連接於該光學儲存裝置之一微處理器以輸入並儲存該複數組寫入策略參數至該調整資料儲存單元。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之高速光學記錄器,其中以調整資料儲存單元係為一揮發性記憶體。
- 9. 如申請專利範圍第2項所述之高速光學記錄器,其中



該時脈產生器包含有一鎖相迴路(Phase Lock Loop, PLL)、以及一頻率除法器(Frequency Divider),該鎖相迴路係用來產生該第一時脈訊號,而該頻率除法器則用來輸入該第一時脈訊號以產生該第二時脈訊號。

- 10. 如申請專利範圍第2項所述之高速光學記錄器,其中該第二時脈訊號之週期係等於該八對十四調變波形之基準週期(EFM Base Period)。
- 11. 如申請專利範圍第2項所述之高速光學記錄器,其中該第二時脈訊號之週期係為該第一時脈訊號之週期的倍數。
- 12. 如申請專利範圍第 2項所述之高速光學記錄器,其中該延遲調整狀態機延遲該八對十四調變波形之解析度(Resolution)係等於該第二時脈訊號之週期。
- 13. 如申請專利範圍第2項所述之高速光學記錄器,其中該粗略延遲計數器包含有一輸入暫存器、一計數器、一比較器、以及一輸出暫存器。
- ·4. 如申請專利範圍第 2項所述之高速光學記錄器,其中該粗略延遲計數器延遲該第二延遲訊號之解析度係等於該第一時脈訊號之週期。



- 15. 如申請專利範圍第 1項所述之高速光學記錄器,其中該複數個延遲單元係為複數個相互串接之反向器,而該精密延遲鏈另包含有一多工器,用來從該複數個反向器之輸出訊號中選擇該寫入訊號。
- 16. 如申請專利範圍第1項所述之高速光學記錄器,其中該精密延遲鏈延遲該第一延遲訊號之解析度係等於該預定時間。
- 17. 如申請專利範圍第16項所述之高速光學記錄器,其甲該預定時間係等於該第二時脈訊號之週期的三十二分之一。
- 18. 如申請專利範圍第 1項所述之高速光學記錄器,其中該八對十四調變波形係由該光學儲存裝置之一八對十四調變編碼器 (EFM Encoder) 所輸入。



